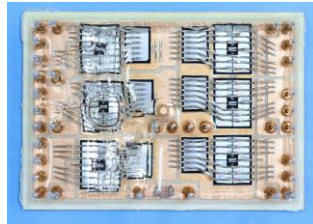
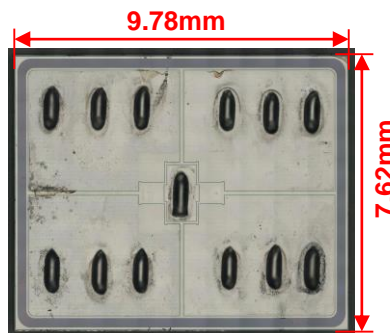


Infineon製 EasyPACK IGBTモジュール「FS100R12W2T7_B11」 (TRENCHSTOP IGBT7) 構造解析、プロセス解析オープンレポート

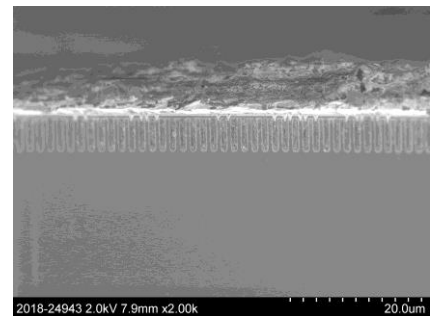
株式会社エルテックは、Infineon IGBT モジュール「FS100R12W2T7_B11」に搭載されている第7世代IGBT(IGBT7)の構造解析、プロセス・デバイス解析レポートをリリースしました。



モジュール写真



チップ写真



セル部断面SEM写真

製品の特徴

「FS100R12W2T7_B11」は、Infineon最新の第7世代IGBTを搭載 $V_{ces}=1200V$ 、 $I_c=100A$ 。
アプリケーションとしては、産業用ドライブ向けの製品になります。

IGBT7は、飽和電圧 $V_{ce, sat}$ を低減するための新しい高密度Micro Pattern Trench (MPT) 構造/レイアウトセルアレイを特徴としています。

前世代のIGBT6と比較するとIGBT7は、 $V_{ce}(sat)$ が1.85Vから1.5Vに約19%程度改善されています。

解析のポイント

- ・単位IGBTセルは7つのトレンチのグループによって形成され、これらのトレンチの接続について明らかにしています。
- ・製造プロセス技術について、最小加工寸法であるコンタクト開口部から有効なプロセス技術ノードを抽出しています。
- ・IGBT7とIGBT6トランジスタのオフ時コレクタリーク電流を比較。活性化エネルギーの有意差が確認されます。
- ・IGBTチップと並列接続されたFWDのブレーダウン電圧をそれぞれ測定しています。

レポート内容と価格

○IGBT7プロセス、デバイス特性解析レポート: 40万円 (税別)

2. IGBT7プロセス、デバイス特性解析レポート

【目次】		頁
1	Infineon第7世代IGBT7(FS100R120C2T7) エグゼクティブサマリー	3
1-1	IGBT5, IGBT6とIGBT7の特性比較	4-5
1-2	モジュール構造とチップ実装	6
1-3	Si IGBTチップ全体	7
1-4	MPT IGBTセル模式図とその等価回路要素	8
1-5	平面構造解析(SEM)	9
1-6	MPT IGBTユニットセル構成	10
1-7	IGBTセルの進化	11
2	Infineon第7世代IGBT7(FS100R120C2T7)解析結果まとめ	12-13
3	3-1 デバイス構造:チップ端部(平面構造解析)	14
3-2	デバイス構造:チップ端部(断面構造解析)	15-16
3-3	デバイス構造:チップ端部(Channel Stopper)	17-19
3-4	デバイス構造: IGBTアレー(断面構造解析)	20-22
4	製造プロセスフロー解析	23
4.1	Si-IGBTのフロントエンドウェーハプロセスフロー(推定)	24
4.2	アライメントツリー	25
4.3	INFINEON IGBT7のプロセス・シーケンス断面図	26-31
4.4	IGBT構成とレイアウト	32-34
5	電気特性評価	35
5-1	電気特性評価: 測定箇所	36
5-2	電氣的特性: Ic-Vce特性	37-38
5-3	電氣的特性: オフ状態のコレクタ電流特性	39-41
5-4	電氣的特性: IGBT-7のオフ状態のコレクタ電流と活性化エネルギーEa	42
5-5	電氣的特性: オフ状態のコレクタ耐圧電圧	43
5-6	電氣的特性: IGBT7とIGBT6のオフリーク電流の比較	44
6	関連文献目録	45
7	関連特許目録	46-51